**Шишлянников Антон Валерьевич. Исследование методов формирования структур с критическими размерами до 10 нм электронно-лучевой литографией на основе HSQ резиста;[Место защиты: ФГБУН Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук], 2021**